



汕头华汕电子器件有限公司

PNP SILICON TRANSISTOR

H1068

对应国外型号
2SB1068

主要用途

音频放大。

极限值 ($T_a=25^\circ\text{C}$)

T_{stg} ——贮存温度.....	-55~150
T_j ——结温.....	150
P_C ——集电极耗散功率.....	750mW
V_{CBO} ——集电极—基极电压.....	-20V
V_{CEO} ——集电极—发射极电压.....	-16V
V_{EB0} ——发射极—基极电压.....	-6V
I_C ——集电极电流.....	-2A
I_{CP} ——集电极电流.....	-3A

TO-92



1—发射极, E
2—集电极, C
3—基极, B

电参数 ($T_a=25^\circ\text{C}$)

参数符号	符 号 说 明	最小值	典型值	最大值	单 位	测 试 条 件
BV_{CBO}	集电极—基极击穿电压	-20			V	$I_C=-100\mu\text{A}$, $I_E=0$
BV_{CEO}	集电极—发射极击穿电压	-16			V	$I_C=-10\text{mA}$, $I_B=0$
BV_{EB0}	发射极—基极击穿电压	-6			V	$I_E=-1\text{mA}$, $I_C=0$
$H_{\text{FE}}(1)$	直流电流增益	135	350	650		$V_{\text{CE}}=-2\text{V}$, $I_C=-100\text{mA}$
$H_{\text{FE}}(2)$		100				$V_{\text{CE}}=-2\text{V}$, $I_C=-1.5\text{A}$
$V_{\text{CE(sat)}}$	集电极—发射极饱和电压		-0.25	-0.4	V	$I_C=-1\text{A}$, $I_B=-10\text{mA}$
			-0.31	-0.5	V	$I_C=-1.5\text{A}$, $I_B=-75\text{mA}$
			-0.33	-0.5	V	$I_C=-1.5\text{A}$, $I_B=-20\text{mA}$
V_{BE}	基极—发射极电压	-550	-600	-650	mV	$V_{\text{CE}}=-6\text{V}$, $I_C=-5.0\text{mA}$
I_{CBO}	集电极—基极截止电流			-100	nA	$V_{\text{CB}}=-16\text{V}$, $I_E=0$
I_{EB0}	发射极—基极截止电流			-100	nA	$V_{\text{EB}}=-6\text{V}$, $I_C=0$
f_T	特征频率	100	180		MHz	$V_{\text{CE}}=-10\text{V}$, $I_E=-50\text{mA}$
C_{ob}	共基极输出电容		60		pF	$V_{\text{CB}}=-10\text{V}$, $I_E=0$, $f=1\text{MHz}$

分档及其标志

L

K

U

135—270

200—400

300—650